

固体辐射物理研究室知识库

ALL

精确检索请加双引号

Go

首页 研究单元&专题 作者 文献类型 学科分类 知识图谱 新闻&公告

XJIPC OpenIR > 固体辐射物理研究室

一种总剂量辐照对PMOSFET负偏压温度不稳定性影响的试验方法

崔江维¹; 郑齐文¹; 魏莹¹; 孙静¹; 余学峰¹; 郭旗¹; 陆妩¹; 何承发¹; 任迪远¹

2018-05-15

专利权人 中国科学院新疆理化技术研究所

授权日期 2020-10-09

专利类型 发明专利

摘要 本发明涉及一种总剂量辐照对PMOSFET负偏压温度不稳定性影响的试验方法, 该方法是由试验样品分组及测试参数选择; 试验样品的总剂量辐照及退火试验; 试验样品的负偏压温度不稳定性测量组成, 为了保证试验结果的一致性和准确性, 首先将样品分为预辐照组、对比组及两个摸底试验组, 在摸底试验的基础上对预辐照组开展确定条件下总剂量辐照和退火试验, 再将对比组和预辐照组开展相同条件下的负偏压温度不稳定性试验, 对比试验结果, 获得总剂量辐照对样品负偏压温度不稳定性影响。本发明提供的方法能够表征总剂量辐照对P沟道金属氧化物半导体场效应晶体管负偏压温度不稳定性影响。

申请日期 2017-12-13

专利状态 已授权

申请号 CN201711329107.0

公开(公告)号 CN108037438B

代理机构 乌鲁木齐中科新兴专利事务所 65106

文献类型 **专利**

条目标识符 <http://ir.tianshanzw.cn/handle/365002/6484>

专题 固体辐射物理研究室

推荐引用方式 崔江维, 郑齐文, 魏莹等. 一种总剂量辐照对PMOSFET负偏压温度不稳定性影响的试验方法. CN108037438B[P]. 2018-05-15. **GB/T 7714**

条目包含的文件

条目无相关文件。

所有评论 (0)

[发表评论/异议/意见]

暂无评论

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。

个性服务

推荐该条目

- ★ 保存到收藏夹
- 👁 查看访问统计
- 📄 导出为Endnote文件

谷歌学术

- 📖 谷歌学术中相似的文章
- 📖 [崔江维]的文章
- 📖 [郑齐文]的文章
- 📖 [魏莹]的文章

百度学术

- 📖 百度学术中相似的文章
- 📖 [崔江维]的文章
- 📖 [郑齐文]的文章
- 📖 [魏莹]的文章

必应学术

- 📖 必应学术中相似的文章
- 📖 [崔江维]的文章
- 📖 [郑齐文]的文章
- 📖 [魏莹]的文章

相关权益政策

暂无数据

收藏/分享

